

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ Ядерных Исследований

Дубна

P14-97-115

И.В.Алексеев¹, С.Г.Абдинова²

СПЕКТРАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТКЛИКА НЕЛИНЕЙНОГО ДЕТЕКТОРА γ-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ TIInSe₂

Направлено в журнал «Nuclear Instruments and Methods, А»

¹Институт физики АН Азербайджана, 370143, Баку, Азербайджан ²Кафедра физики, Нефтяная академия, 370020, Баку, Азербайджан



Спектральное распределение эффективности f(E) и отклика I(E) являются важными характеристиками детекторов и детекторных материалов. Первая рассчитывается методом Монте-Кардо, который, как известно, позволяет решать задачи о поглошении радиации в ограниченных средах. Такие расчеты для твердотельных детекторов проводились рядом авторов [1-3].

Расчет спектра I(E) в линейном случае также не составляет труда, так как, исключая область очень малых энергий E, он идентичен спектру f(E). Однако. как правило, полупроводники с высокой чувствительностью к радиации, такие, как CdSe, CdTe, TlInSe2.- имеют сублинейную амперваттную характеристику (ABX). В этом нелинейном случае упомянутая идентичность уже не имеет места. Вид I(E)определяется уже не только процессом генерации свободных зарядов (как для f(E)или I(E) в линейном случае), но также и процессами обмена между зоной разрешенных состояний и локальными центрами запрещенной зоны. Существенно влияет на I(E) в нелинейном случае также и неравномерность поглощения радиации по глубине образца.

В настоящей работе показано, что при определенных условиях расчет I(E) в нелинейном случае может быть проведен на основе данных по f(E) с использованием некоего параметра s < 1, получаемого аналитически и содержащего сведения о форме экспериментальных ABX детектора. Для расчета f(E) использовалась программа моделирования электромагнитных ливней ELSS [4], адаптированная для ПВЭМ типа ІВМРС. Эффективность, имеющая смысл относительной доли энергии фотона, преобразованной в кинетическую энергию свободных зарядов в объеме образца, определялась в ELSS как отношение E - W/E, где E - энергия γ -кванта, падающего на образец, а W - суммарная энергия у-квантов и свободных зарядов, покидающих образец.

Как упоминали, кристаллы TlInSe имеют сублинейную ABX. Она может быть представлена степенной функцией $I \sim G^{\alpha}$, где I - отклик детектора, G - мощность излучения, поглощенная в образце, а показатель $\alpha \leq 1$, определяется экспериментально [5]. Следовательно, для случая равномерного (слабого) поглощения спектр I(E) можно описать следующим соотношением:

$$I(E) = I(E') \left\{ \frac{G(E)}{G(E')} \right\}^{\alpha} .$$
(1)

Злесь Е' - любое фиксированное значение энергии из рассматриваемого интервала

Для спектра $I_F(E)$, приведенного к равной плотности потока энергии излучения F, в соотношении (1) G можно заменить на f:

$$(E) = I(E') \left\{ \frac{f(E)}{f(E')} \right\}^{\alpha} .$$
(2)

(3)

В общем случае соотношения (1) и (2) нуждаются в коррекции, учитывающей влияние нелинейности в условиях неравномерного поглощения радиации по толщине образца. Для этого рассмотрим отношение

 $s(E) = I(E)/\bar{I}(E),$

где I и Ī - отклик образца для двух предельных случаев: отсутствия диффузионного выравнивания и, наоборот, "мгновенного" диффузионного выравнивания по толщине образца концентрации свободных зарядов, генерированных радиацией. Опуская элементарные рассуждения, запишем для I и Ī:

$$I(E) = a \int j(x) dx = a j(x=0) \int \left(\frac{g(x)}{g(x=0)}\right)^{\alpha} dx , \qquad (4)$$

$$I(E) = ad \cdot j(x=0) \left(\frac{\bar{g}}{g(x=0)}\right)^{\alpha}, \qquad (5)$$

где использовали соотношение типа (1), примененное к плотности тока j, текущего в элементарном слое образца. В (4) и (5) g(x = 0) - мощность излучения, поглощенная в единице объема элементарного слоя на приемной поверхности образца, j(x = 0) - плотность тока в этом слое, g(x) и j(x) - то же для слоя на глубине x, ad - площадь электродов образца, а \bar{g} - отношение G к объему образца, т.е.

 $\bar{g}=\frac{1}{d}\int g(x)dx\,.$

Отметим, что j(x = 0) в выражениях (4) и (5) идентичны, а g(x) = $F(0)\mu_n exp(-\mu x)$, где μ_n и μ - линейные коэффициенты поглощения энергии и ослабления соответственно. Поэтому после несложных преобразований получим

$$s(E) = \frac{(\mu d)^{\alpha} (1 - \exp(-\mu d\alpha))}{\mu d\alpha (1 - \exp(-\mu d))^{\alpha}} \quad . \tag{6}$$

При определении (6) мы пренебрегли незначительным изменением качественного состава излучения с глубиной.

Соотношения (1) и (2), описывающие спектральное распределение отклика нелинейного детектора для случая равномерного (слабого) поглощения, справедливы, очевидно, и для $\bar{I}(E)$, введенного для случая "мгновенного" диффузионного выравнивания концентрации генерированных свободных зарядов. Поэтому

$$I(E) = \frac{I(E')}{G^{\alpha}(E')}G^{\alpha}(E)s(E),$$

или в расчете на единицу плотности потока энергии:

 $I_F(E) = \frac{I(E')}{f^{\alpha}(E')} f^{\alpha}(E) s(E) \,.$ (7)

Выражение (7) используется в случаях, когда можно пренебречь влиянием диффузии на распределение концентрации генерируемых радиацией свободных зарядов. Такая ситуация реализуется в полупроводниках с монополярной проводимостью и достаточно высокой чувствительностью к излучению [6]. К таким полупроводникам относится и TlInSe₂.

Из (6) видно, что s = 1 при слабом поглощении (µd << 1) и убывает с усилением поглощения до значения $s = (\mu d)^{\alpha}/\mu d\alpha$ при $\mu d >> 1$.

3

Таким образом рассмотренный коэффициент s корректируст эффект, обусловленный нелинейностью детектора в условиях неоднородного поглощения радиации и, приводящий к относительному снижению чувствительности детектора с длинноволновой стороны спектра. Эффект тем значительнее, чем сильнее поглощение и отклонение ABX от линейной, т.е. чем больше μd и меньше α .

Сравнение расчета с экспериментом проводили для спектров, приведенных к равной мощности экспозиционной дозы *P*, т.к. мониторирование пучка излучения в этом случае осуществляется проще. Для данного спектра выражение (7) приобретает вид

$$f_P(E) = const \cdot (F_0(E) \cdot f(E))^{\alpha} \cdot s(E), \qquad (8)$$

где $I_P(E)$ - плотность потока энергии излучения, создающая единичную экспозиционную дозу, численно равная отношению энергетического эквивалента рентгена к массовому коэффициенту поглощения энергии в воздухе [7]. В отличие от расчетов, где излучение предполагали монохроматическим, в эксперименте использовали сплошное тормозное излучение, гомогенизированное посредством медной фильтрации. Измерения проведены в интервале 0.02 - 0.13 МэВ эффективных энергий рентгеновского излучения и дополнены точкой E = 1.25 МэВ. Методика измерений описана в [5].

На рис.1 приведены экспериментальные кривые спектров $I_P(E)$ для образцов $TlInSe_2$ различной толщины. В нижней части того же рисунка - кривые, рассчитанные по (8) для тех же образцов.Показатель степени *а* для исследованных образцов составлял 0.5.

В расчетных спектрах, как и в экспериментальных, наблюдаем наличие широкого максимума, его смещение с изменением толщины образцов, крутой спад с длинноволновой стороны спектра и пологий - с коротковолновой.

Заметно отклонение данных эксперимента от расчетных в интервале 90-130 кэВ. Превышение экспериментальных данных над расчетными обусловлено свойством монте-карловской программы ELSS, где невозможно учесть значительный скачок поглощения в $TlInSe_2$ при E = 85.5 кэВ (K-скачок Tl).

О правомерности описанной методики расчета говорит, помимо схожести общего вида расчетного и экспериментального спектров, также и согласие по такой количественной характеристике спектра, как отношение отклика в максимуме спектра к отклику в точке E = 1.25 МэВ.Для образцов с толщиной d = 0.05 см, 0.104 см и 0.21 см расчет дает значения 10.75, 7.04 и 5.05 соответственно, а измерения по исследованной группе образцов дали средние результаты :10, 7 и 5.

выводы

Расчет спектрального распределения отклика полупроводникового детектора с нелинейной характеристикой возможен на основе данных по эффективности, полученных методом Монте-Карло. Нелинейность характеристики и неоднородность поглошения радиации в объеме чувствительного элемента учитываются с помощью корректирующего коэффициента $s \leq 1$. Данный метод расчета не требует сведений о рекомбинационных и иных захватных процессах в полупроводнике. Он используется, когда

-



Экспериментальные (верхняя часть рисунка) и расчетные (инжияя часть рисунка) кривые спектрального распределения отклика образнов $TUnSe_2$ с толщиной d = 0.21 см (сплошная), 0.104 см (штриховая) и 0.05 см (штрихиунктириая линии). В углу нижнего рисунка - кривые эффективности f(E) соответствующих образцов.

Воъскъясна ваструт Слевних неслековкого БИБЛИОТЕКА можно пренебречь влиянием диффузии на распределение концентрации генерируемых радиацией свободных зарядов.

Литература

[1] E.Caroli et al. Nucl. Instr. and Meth. A322 (1992) ,39
 [2] U.Corti et al. Nucl. Instr. and Meth. A322 (1992) 591
 [3] U.Bottigli et al. Nucl. Instr. and Meth. A338 (1994) 549
 [4] Ц.А. Аматуни. Препринт ЕФИ-375(50)-84, Ереван, (1984)
 [5] И.В. Алексеев. Изв. РАН, Неорг. матер., 28, 2404, 1992
 [6] С.М. Рывкин. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. М.1963
 [7] В.П., Машкевич. Защита от ионизирующих излучений. Справ., М., 1982

Рукопись поступила в издательский отдел 3 апреля 1997 года. Алексеев И.В., Абдинова С.Г. Спектральное распределение отклика нелинейного детектора у-излучения на основе TlInSe,

С использованием метода Монте-Карло рассчитано спектральное распределение отклика TIInSe₂-детектора ү-излучения. Нелинейность детектора и неоднородность поглощения радиации учитывали с помощью корректирующего коэффициента s (E), который зависит от энергии ү-квантов, толщины кристалла и формы ABX. Данный способ коррекции правомерен в случае, когда несущественно влияние диффузии на распределение неравновесных носителей заряда в объеме полупроводника. Проведено сравнение расчета с экспериментом в интервале 0,02 — 1,25 МэВ энергий ү-квантов.

Работа выполнена в Лаборатории нейтронной физики им.И.М.Франка ОИЯИ.

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 1997

Перевод авторов

P14-97-115

P14-97-115

Alekseyev I.V., Abdinova S.G. The Calculation of the Spectral Distribution of the Response of Non-Linear Detector for γ-Radiation

Spectrum distribution of response of $\text{TIInSe}_2 \gamma$ -detector was calculated using Monte Carlo method. Non-linearity of amper-watt characteristics (AWC) of the detector and inhomogeneity of radiation in the crystal were corrected by means of the coefficient $s \leq 1$, which depends on γ -quantum energy, crystal thickness and the form of AWCH. The comparison of the calculated and experimental data was carried out in the range of 0.02 - 1.25 MeV.

The investigation has been performed at the Frank Laboratory of Neutron Physics, JINR.

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 1997